



kingston.com/epop

ePoP

Встраиваемая память типа «корпус на корпусе» для носимых устройств

Компоненты ePoP компании Kingston — это компоненты высокой степени интеграции, соответствующие стандарту JEDEC, объединяющие Embedded MultiMedia Card (eMMC) и Low-Power Double Data Rate (LPDDR) DRAM в решении типа «корпус на корпусе» (PoP). Компонент ePoP устанавливается непосредственно поверх совместимой хост-системы на кристалле (SoC), что уменьшает занимаемое пространство на печатной плате (PCB) и обеспечивает оптимальную производительность. ePoP — идеальное решение для применения в ограниченном пространстве, например, в носимых устройствах.

[подробнее >>](#)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компоненты ePoP устанавливаются непосредственно на SoC и представляют собой идеальный выбор для таких решений с малым форм-фактором, как носимые устройства.
- Память Low-Power DRAM и оптимизированное встроенное ПО хранилища данных снижают энергопотребление, обеспечивая при этом высокую производительность, необходимую для носимых устройств с питанием от аккумулятора.
- Упрощает проектирование систем, уменьшает время выхода на рынок и сокращает квалификационный цикл.
- Доступны различные варианты прошивок, что позволяет выбрать наиболее соответствующую вашим требованиям к производительности, потребляемой мощности и ресурсу.

РЫНОЧНЫЕ СЕГМЕНТЫ



Интернет вещей



Носимые устройства



Устройства дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR)

АТИКУЛЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ EPOP

ePoP на базе LPDDR4x

Артикул	Емкость		Описание		Корпус	FBGA	Рабочая температура
	NAND (ГБ)	DRAM (Гбит)	eMMC	DRAM	(мм)		
64EP16-M4MTB9W	64	16	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,6	144	от -25 до +85 °C
64EP32-M4NTB9W	64	32	5,1	LPDDR4x	8 x 9,5 x 0,65	144	от -25 до +85 °C

ePoP на базе LPDDR5x

Артикул	Емкость		Описание		Корпус	FBGA	Рабочая температура
	NAND (ГБ)	DRAM (Гбит)	eMMC	DRAM	(мм)		
64EP16-M5ATB9W	64	16	5,1	LPDDR5x	8 x 9,5 x 0,58	201	от -25 до +85 °C
64EP32-M5BTB9G	64	32	5,1	LPDDR5x	8 x 9,5 x 0,65	201	от -25 до +85 °C
64EP32-M5BTB9M	64	32	5,1	LPDDR5x	8 x 9,5 x 0,7	201	от -25 до +85 °C

